
 	<h2 style="color: red;">FQD11P06TF</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD11P06TF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 60V 9.4A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD11P06TF.pdf</a> <a href="#">2.FQD11P06TF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD11P06TF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 9.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 38W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	185 mOhm @ 4.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	550pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD11P06TF ist neu im Original, Suche FQD11P06TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD11P06TF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD11P06TF: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD11P06-NL</b> FSC FQD11P06-NL FSC</p>	 <p><b>FQD11P06TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 9.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD11P06TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 9.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD1216ME/I H-5</b> NXP</p>
 <p><b>FQD11P06</b> F FQD11P06 F</p>	 <p><b>FQD12N20</b> F FQD12N20 F</p>	 <p><b>FQD11N60C</b> FAIRCHI FAIRCHI TO-252</p>	 <p><b>FQD11P06TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 9.4A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQD10N20	↔ FQD10N20C	⇒ FQD10N20CTF	D FQD10N20CTF	↔ FQD10N20CTM
⊕ FQD10N20CTM	⊗ FQD10N20D	D FQD10N20L	⇒ FQD10N20LTF	↔ FQD10N20LTF
⊗ FQD10N20LTM	⊕ FQD10N20LTM	⊗ FQD10N20TF	↔ FQD10N20TF	↔ FQD10N20TM
D FQD10N20TM	⊗ FQD11P06	⊕ FQD11P06-NL	⊗ FQD11P06TF	↔ FQD11P06TM
⇒ FQD11P06TM	↔ FQD12N10	⊗ FQD12N20	⊕ FQD12N20L	↔ FQD12N20LTF
↔ FQD12N20LTF	⇒ FQD12N20LTM	D FQD12N20LTM	⊗ FQD12N20TF	⊕ FQD12N20TF
⊗ FQD12N20TM	D FQD12N20TM	⇒ FQD12P10	↔ FQD12P10TF	↔ FQD12P10TF
⊕ FQD12P10TM	⊗ FQD12P10TM	↔ FQD13N06	⇒ FQD13N06L	↔ FQD13N06LTF
⊗ FQD13N06LTF	⊕ FQD13N06LTM	⊗ FQD13N06LTM	D FQD13N06LTM-NL	↔ FQD13N06TF
↔ FQD13N06TF	⊗ FQD13N06TM	⊕ FQD13N06TM	⊗ FQD13N10	↔ FQD13N10L

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited